

TIP122-157
硅 NPN 外延平面晶体管芯片 (4 ")
■用途

- * 电源调整管
- * 音频功率放大器
- * 其他电子电路

■特征

- * 最大集电极电流 I_{CM} : 2A

■电特性(Ta=25°C)

参数名称	符号	测试条件	典型值	最小	最大	单位
集电极--基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C=0.1mA, I_E=0$	260	150		V
集电极--发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C=10mA, I_B=0$	150	100		V
集电极--发射极维持电压	$V_{CEO} (sus) *$	$I_C=20mA, I_B=0$		100		V
发射极--基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_E=1mA, I_C=0$		4		V
集电极--基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=150V, I_E=0$			1	μA
集电极-发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE}=100V, I_B=0$			1	μA
发射极--基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=10V, I_C=0$	1.3		2.5	mA
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=5V, I_C=1A$		2K	15K	
集电极--发射极饱和电压	V_{CES}	$I_C=3A, I_B=12mA$	1.2		1.8	V

* $V_{CEO} (sus)$: 脉宽 $\leq 300 \mu s$, 占空比 $\leq 2\%$ (TO—220)